(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許出顧公告番号

特公平6-32307

(24) (44)公告日 平成 8年(1994) 4月27日

(51)Int.CL\* -

H 0 5 B 33/22

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

Eg. 5.061,569

発明の数1(全 11 頁)

(21)出顯番号

特顧昭59-58088

(22)出題日

昭和59年(1984) 3月26日

(65)公開番号

特開昭59—194393

(43)公開日

昭和59年(1984)11月5日

(31)優先權主張番号

478938

(32)優先日

1983年 3 月25日

(33)優先権主張国

米国 (US)

(71)出頭人 999999999

イーストマン コダツク カンパニー アメリカ合衆国 ニューヨーク州 14650 ロチェスター市 ステート ストリート

343

(72)発明者 スチープン・アーランド・パンスリク

アメリカ合衆国ニユーヨーク州14613ロチ

エスター市ピアーポント・ストリート324

(72)発明者 チャン・ウオン・タン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州14626ロチ

エスター市パーモント・ドライブ197

(74)代理人 弁理士 湯浅 恭三 (513名)

審查官 紀本 孝

(58)参考文献 特開 昭57-51781 (JP, A)

#### (54) 【発明の名称】 改良された電力転換効率をもつ有機エレクトロルミネツセント装置

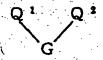
. 1

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 順次陽極、正孔インジェクション帯域、有機発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは1 μ m を越えない)、及び陰極からなる少なくとも9×10<sup>-5</sup>W/Wの電力転換効率をもつエレクトロルミネッセント装置であって、

これらの電極のうち少なくとも一方は400 n m以上の 波長をもつ輻射線の少なくとも80%を透過させること ができ、且つ

前記正孔インジェクション帯域が次の式を有する化合物であり、



2

ここにおいて、Q¹及びQ²は別個に窒素原子及び少なくとも3個の炭素環(それらの少なくとも1個は芳香族のもの)を有する基であり、Gはシクロアルキレン基、アリーレン基、アルキレン基又は炭素ー炭素結合からなる連結基である、エレクトロルミネッセント装置。

## 【発明の詳細な説明】

本発明は、有機化合物を発光手段とする、電気信号に応 答して発光するエレクトロルミネツセント装置に関す ス

有機エレクトロルミネツセント装置がそれらの対抗品と十分に対抗しうるものとなるためには、対抗しうるコストにおいてそれらの電力転換効率が増大することが望ましい。電力転換効率は入力に対する出力の比(通常はW/W)と定義され、装置の駆動電圧の関数である。経済的な駆動回路部品を用いる駆動電圧、すなわち25ボル

を越えない電圧に関しては、電力転換効率は無機装置 場合1×10<sup>-5</sup>W/W以下に限定されている。10<sup>-5</sup> /W以上の電力転換効率をもつ、厚いフィルム (>5 n) または単結晶を用いる有機エレクトルミネジセン 装置が開発されてはいる。しかしそれらの厚さが比較 たきいため、この種の装置を駆動させるのに要する電 まかなり高い、すなわち100ボルトまたはそれ以上 ある。

聞圧を25ポルト以下に低下させるためには薄膜型 ノクトロルミネツセント装置が望ましい。これはここ 10 は有効な帯域または層の厚さ、すなわち電極間にある **፪の厚さが1μmを越えない装置を意味する。ピンホ** Vの問題を考えると薄膜の形態を達成することは特に 誰であった。ピンホールは電池をショートさせるので **しれられない。たとえばドレスナー、RCAレビュ** Vol. 30、322ff頁(1969年6月)、特 326頁を参照されたい。ピンホールの形成を防止す とめに、被覆用配合物中に結合剤を使用することが好 今とされている。この種の結合剤の例には付加重合体 とえばポリスチレン、および縮合重合体たとえばポリ ステルが含まれる。電池のショートは避けられるが、 ♠剤を使用することは不満足な場合がある。このため **は溶剤被覆加工法を用いる必要があり、ある層の溶剤** 下層の溶剤としても作用する可能性があり、これによ 冒間の明瞭な境界設定が妨げられる。結合剤を必要と 31層を溶剤被覆したのち結合剤を必要としない層 1層または多層)を蒸着させる方法は考えられるが、 の順序すなわち発光層を溶剤被覆する場合、溶剤が下 こ影響を与えた場合の実用性は照明されていない。 国特許第4,356,429号明細書に記載された電 30 は、正孔インジエクション帯域(hole injecting zon としてポルフィリン系化合物からなる層をもつ本発 **りものと同じ型の装置の一例である。** 

R特許のセルは先行技術のセルよりも著しい改良を示とが、望まれている電力転換効率、すなわち25ボルを越えない駆動電圧を用いた場合に少なくとも9×1 °W/Wの水準を達成していない。正孔インジェクシン層内のポルフイリン系化合物は有色であるため、セにより放出される光を若干吸収するという望ましくな頃向を示す。またポリフイリン系化合物は有効に発光るために必要な正孔および電子の有効な発光的再結合妨げると思われる。

発明の目的は、少なくとも1桁改良された、すなわちなくとも9×10-5W/Wに及び電力転換効率をもつレクトロルミネツセント(以下"EL")装置を提供ることである。

発明によれば、順次陽極、正孔インジエクション帯 ・有効発光帯域(これらの帯域を合わせた厚さは1μ を越えない)、および陰極からなり、

れらの電極のうち少なくとも400nm以上の波長をも 50

4

つ輻射線の少なくとも80%を透過させることができ、 かつ

少なくとも9×10<sup>-5</sup>W/Wの電力返還効率をもつエレクトロルミネツセント装置が提供される。

好ましくはこの装置の発光帯域は、i)25ボルト以下およびii)この装置の最大電力転換効率を与える電圧以下で駆動される試験装置に用いた場合、少なくとも5×10一光子/電子のエレクトロルミネツセント量子効率を与える電子伝達化合物からなる。上記試験装置は1)本質的に1,1ービス(4ージーpートリルアミノフェニル)シクロヘキサンからなる正孔インジエクショク帯域(この正孔インジエクション帯域と上記の発光帯域を合わせた厚さは1μmを越えない)、2)400m以上の波長をもつ輻射線の少なくとも80%を透過させる陽極、および3)インジウム製陰極から構成される。

本発明の装置は必要とされる改良された電力転換効率を示す。

本発明の装置において発光帯域または正孔インジェクション帯域はそれぞれ電子伝達化合物からまたは正孔伝達 化合物から作成され、これは本発明の実施態様の多くに おいてそれぞれの帯域に結合剤を用いずに行われる。 本発明のさらに他の有利な特色は、正孔インジェクショ

本発明のさらに他の有利な特色は、正孔インジエクション層用として、発せられた輻射線に対し実質的に透過性である化合物が見出されたことである。

本発明の他の有利な特色は添付の図面を考慮に入れて後 記の好ましい実施態様を参照することにより明らかにな るであろう。第1回は電源に接続した本発明装置の一部 の概略的断面図であり、

第2回は本発明に従って製造された装置に関する電力転換効率対エレクトロルミネツセン量子効率を示す対数ー 対数グラフである。

正孔インジェクション物質および発光物質は各帯域内に存在する (この帯域が層であっても他のものであっても)。好ましいエレクトロルミネツセント装置においてこれらの物質は順次重なった被膜ないしは層中に存在する。

正孔インジェクション層は正孔伝達化合物からなり、一 方発光層は電子伝達化合物からなる。

本発明者らは、後記のように駆動および構成されるセルに用いた場合に5×10<sup>一</sup>光子/電子を越えるEL量子効率を与える特定の電子伝達化合物があることを見出した。電力転換効率とEL量子転換の間には直接的な関係があるので、これらの化合物を用いると前記の駆動電圧に関して電力転換効率は少なくとも9×10<sup>-5</sup>W/Wとなることが保証される。これらの化合物は容易に薄膜の形態で沈着するので、有効帯域を合わせた厚さが1μmを越えない薄膜型装置が容易に得られる。

本発明の装置に用いられる電子伝達化合物は、酸化選元 反応において選元されうる化合物である。本発明におい て特に有用なものは、前記の試験に関して少なくとも5 ×10<sup>-4</sup>E L量子効率を与える電子伝達化合物である。 周知のようにE L量子効率は単純に外部回路で測定され る電子/秒に対する、セルから放出される光子/秒の比 に等しい。この効率を電力転換効率(W/Wの単位で定 義される)と混同してはならない。

電子伝達化合物が少なくとも5×10<sup>-1</sup>光子/電子(すなわち0.05%)のEL量子効率を与えるか否かを判定するためには下記の試験を行う。

#### ELセルは下記の順序で構成される:

400nm以上の波長をもつ輻射線の少なくとも80%を透過させる陽極(たとえばネザトロン(Nesatron、商標)ガラス);本質的に1,1ービス(4ージーpートリルアミノフェニル)シクロヘキサンからなる正孔インジエクション層;問題の電子伝達化合物の層;およびインジウム製陰極。ここで正孔インジエクション層と発光層は合わせて厚さ1μを越えない。駆動電圧をかけ、最大電子転換効率または25ボルトのいずれかに達するまで(いずれが先に起こるとしても)高める。この電圧において最大EL量子効率を測定する。

表Iには、上記のように構成され、かつ上記の電圧で駆動される装置において試験した場合の若干の有用な電子伝達化合物に関するEL量子効率を示す。これらの例のそれぞれにつき、最大EL量子効率の電圧は25ポルトの制限以下であった。

表	<u> </u>			
構造	最大 <b>凡量子</b> 効率*	測定点におけ る駆動電力		
ネザトロン陽極/エピンドリジオン (1500 A)/イン	2×10 <sup>-4</sup>	187		

ジウム(In)陰極

最大且量子 測定点におけ 構造 る駆動電力 (比較例) ネザトロン陽極/HI-1\*(75nm)/El\*(75nm)/in 1×10-\* **20V** ネザトロン陽極/HI-1(75 nm)/E2\*(75nm)/In陰極 8×10<sup>-3</sup> **20**Y ネザトロン陽極/HI-1(75 nm)/E3\*(75nm)/In陰極 3×10-3 157 ネザトロン陽極/HI-1(75 3×10-12,5V nm)/E46(75nm)/In陰極 ネザトロン陽極/11-1(75 1.5×10-3 247 nm)/E57(75nm)/In陰極 ネザトロン関極/HI-1(75 5×10-3 157 nm)/E6°(75nm)/In陰極 ネザトロン陽極/HI-1(75nm)/In陰極 8×10-3 147

15を除いて有効数子1個に四捨五入した。

## 1エピドリジン=

2HI-1=1, 1-ビス (4-ジーpートリルアミノフェニル) シクロヘキサン 3E1=

**3**0

(4,4'-ビス(5,7-ジーtーペンチルー2ーベ 40※4E2= ンゾキサゾリル)スチルペン) ※

2,5ーピス〔5,7ージーtーペンチルー2ーペン ★5E3= キサゾリル〕チオフェン〕

2, 2' - (1, 4-フェレンジピニレン) ピスペン ※6E4= チアゾール] ※

2, 5-ピス [5- (α, α-ジメチルベンジル) - ☆9E7= -ベンゾキサゾリル] チオフェン] ☆

2,5-ビス (5,7-ジーセーペンチルー2ーベンキサゾリル) -3,4-ジフェニルチオフエン] こで用いられる正孔インジエクション層の正孔伝達化物は、電場を与えられた2個の電極間に配置されて陽から正孔がインジエクトされた場合、正孔を適切に陰から正孔がインジエクトされた場合、正孔を適切に陰から正孔がインジエクトされた場合、正孔を適切に陰かに達することができる化合物である。好ましい正孔40 産化合物は、104~106ボルト/cmの電場を与えらた電極間に層が配置された場合少なくとも10-6cm²ボルトー秒の正孔移動係数をもつ。最も好ましい正孔遠化合物は容易にかつ可逆的に酸化されうる芳香族アンであることが見出された。

り好ましくは、正孔インジェクション層は本質的に無である。これは陽極に関接した位置にあり、陽極は透な電極であることが好ましい。従って正孔伝達化合物400mn以上の波長において少なくとも90%透過であることが好ましい。

◆本発明に用いられる正孔伝達化合物のあるもの、および電子伝達化合物のあるものは、薄膜形成性化合物であるという付加的な性質をもつことが注目される。ここで用いられるようにある化合物がこの物質を電極などの支持体上に0.5μm以下の厚さで施した場合に"薄膜形成化"である場合、これは実質的にピンホールを含まない層を形成する。しかしある化合物が薄膜形成性であるということは必ずしも0.5μmよりも多量に存在しないということを意味するわけではない。有効帯域の一方の層がこの種の薄膜形成性化合物である場合、両層において結合剤を除くことができるという点でこの薄膜形成性は有用である。従って本発明の一実施態様においては、発光層および正孔インジェクション帯域の双方が結合剤を含有しない。

あるいは他の場合には正孔と電子の発光的再結合を妨げ ない結合剤も本発明に有用である。

8

前記のように薄膜を形成しうる化合物の有用な例を以下 に示す。特に有用な例には複素環もしくは炭素環、および3個以上の炭素原子を有する脂肪族類少なくとも2個 を含有するか、あるいは少なくとも2個の基すなわちそれぞれa)一里結合の囲りに回転しうる基およびb)少なくとも3個の芳香族もしくは飽和炭素環を含む基を含有する化合物が含まれる。

たとえば薄膜形成性である正孔伝達化合物には次式の構造をもつものが含まれる。

a )

\*上記式中Q¹およびQ²は別個に窒素原子および少なくとも3個の炭素環(それらのうち少なくとも1個は芳香族のもの、たとえばフェニル基である)を含有する基である。炭素環は飽和された環、たとえばシクロヘキシル基およびシクロヘプチル基であってもよく;Gは連結基、たとえばシクロアルキレン基、たとえばシクロヘキシレン基;アリーレン基たとえばフェニレン基;アルキレン基たとえばメチレン基、エチレン基およびプロピレン基;あるいはC-C結合である。構造a)の範囲内の10個々の例には、特に下記のものが含まれる。次式の構造をもつ1、1-ビス(4-ジーp-トリルアミノフェニル)-4-フェニルーシクロヘキサン;

10

1,1-ビス(4-ジーpートリルアミノフェニル)シ ※ii) クロヘキサン;および次式の構造をもつ化合物 ※30

(上記式中nは2~4の整数である)、たとえば4,4 「ービス(ジフェニルアミノ)クワドリフェニル。 さらに他の有用な正孔伝達化合物には米国特許第4,1 75,960号明細書13欄13行から14欄42行に 列挙されたもの、たとえばビス(4ージメチルアミノー 2-メチルフェニル)フェニルメタンおよびN,N,N ートリ(pートリル)アミンが含まれる。

薄膜形成性の電子伝達化合物に関しては、好ましい例には螢光増白剤が含まれる。 最も好ましいものは次式の構造をもつ螢光増白剤である。

**★b**)

または

c)

れらの式中R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は別個に水素原;1~10個の炭素原子を有する飽和脂肪族残基、たえばプロピル基、tープチル基およびヘプチル基;610個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェル基およびナフチル基;あるいはハロゲン原子、たとば塩素原子およびフツ素原子であるか;あるいはR<sup>1</sup> R<sup>2</sup>、またはR<sup>3</sup>とR<sup>4</sup>が一緒になって、1~10個の素原子を有する飽和脂肪族残基(たとえばメチル基、チル基およびプロピル基)少なくとも1個を含んでいもよい縮合芳香族環を完成するために必要な原子を構し、

\*は1~20個の炭素原子を有する飽和脂肪族残基、 とえばメチル基、エチル基およびn-アイコシル基; ~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフ 20 ニル基およびナフチル基;カルボキシル基;水素原 ;シアノ基;あるいはハロゲン原子、たとえば塩素原 およびフツ素原子であり;ただし式c)においてR<sup>3</sup>, \*およびR<sup>5</sup>のうち少なくとも2個は3~10個の炭素 子を有する飽和脂肪族残基、たとえばプロピル基、ブル基またはヘプチル基であり、

は一〇一、一NHーまたは一S一であり;

 $R^6$ -(CH=CH-)- $R^6$ -.

CH=CH-.

(-CH=CH-) R6-(-CH=CH-) R-

たは

12

であり、

mは0~4の整数であり;

nは0, 1, 2または3であり;

R<sup>8</sup>は6~10個の炭素原子を有するアリーレン基、た ) とえばフェニレン基およびナフチレン基であり; R<sup>7</sup>は水素原子または6~10個の炭素原子を有するア リール基であり;そして

Z' およびZ' は別個にNまたはCHである。

上記の脂肪族残基は置換されていてもよい。置換された脂肪族残基の場合の置換基には、1~5個の炭素原子を有するアルキル基、たとえばメチル基、エチル基およびプロピル基;6~10個の炭素原子を有するアリール基、たとえばフェニル基およびナフチル基;ハロゲン原子、たとえば塩素原子およびフツ素原子;ニトロ基;ならびに1~5個の炭素原子を有するアルコキシ基、たとえばメトキシ基、エトキシ基およびプロポキシ基が含まれる。

特に好ましい螢光増白剤の例には下記のものが含まれる。2,5ーピス(5,7ージーtーペンチルー2ーペンゾキサゾリル)ー1,3,4ーチアジアゾール;4,4'ーピス(5,7ーtーペンチルー2ーペンゾキサゾリル)スチルペン;2,5ーピス(5,7ージーtーペンチルー2ーペンゾキサゾリル)チオフェン;2,2'ー(pーフェニレンジピニレン)ーピスペンゾチアゾール;4,4'ーピス(2ーペンゾキサゾリル)ピフェニル;2,5ーピス(5ー(α,αージメチルペンジル)ー2ーペンゾキサゾリル)チオフェン;4,4'ーピス(5,7ージー(2ーメチルー2ーブチル)ー2ーペンゾキサゾリル)スチルペン;および2,5ーピス(5,7ージー2ーメチルー2ーブチル)ー2ーペンゾキサゾリル)スチルペン;および2,5ーピス(5,7ージー2ーメチルー2ーブチル)ー2ーペンゾキサゾリル)ー3,4ージフェニルチオフェン。

さらに他の有用な螢光増白剤はケミストリー・オブ・シンセティック・ダイズ、1971、628~637頁および640頁に列挙されている。すでに薄膜形成性ではないものは、一端または両端の環に脂肪族の基を結合させることによって薄膜形成性にすることができる。この種のさらに有用な螢光増白剤には、たとえば下記のものが含まれる。

ル) ピニル) ペンゾイミダゾール)

(5-メチルー2- {2-(4-(5-メチルー2-ベ \*ル) ンゾキサゾリル) フェニル) ピニル} ペンゾキサゾー \*

〔2,5ーピス(5ーメチルー2ーベンゾキサゾリル) チオフェン〕

【2-【2-(4-カルボキシフェニル】ビニル】ベン ゾイミダゾール】

および

(2-(2-(4-クロルフェニル) ピニル) ナフト <math>(1, 2-d) オキサゾール)

さらに他の有用な薄膜形成性の電子伝達化合物には8ーヒドロキシキノリンの金属錯体が含まれ、その際金属は好ましくはZn、Al、MgまたはLiである。

有効層の一方が薄膜形成性である場合、容易に認められるようにピンホールのため装置がショートすることはないので、他方は薄膜形成性である必要はない。たとえば有用な装置は、前記の薄膜形成性化合物からなる正孔インジェクション層、および薄膜形成性でない化合物、たとえば1,1,4,4-テトラフェニルー1,3-ブタジェンからなる発光層を含む。

前記の表 I から明らかなように、有用な陽極電極には商標 "ネザトロン"のもとにPPGインダストリーズ社から得られる被覆ガラス陽極が含まれ、有用な陽極電極にはインジウムが含まれる。一般のいかなる陽極および陰極もそれが適切な仕事関数値をもつならば使用できる。たとえば陽極は高い仕事関数をもつべきである。他の有

用な陽極の例にはいずれかの半透明な高い仕事関数をも※50

※つ選電性材料、たとえば酸化スズインジウム、酸化ス ズ、ニッケルまたは金で被覆したガラスが含まれる。好ましくは、この種の陽極は10~1000オーム/スク エアー(ohms/square)のシート抵抗、および400mm 以上の波長に対し80%の光透過率をもつ。このように 高い光透過率を少なくとも90%という正孔伝達化合物 20 の透過率と合わせた場合に、本発明に従って作成された 装置の特色である卓越した電力転換効率が保証される。 他の有用な陰極の例には低い仕事関数をもつ他の金属、 たとえば銀、スズ、鉛、マグネシウム、マンガンおよび アルミニウムが含まれる。金属が装置により発生するル ミネツセンスに対して高い透過率をもつか否かは関係な

14

第1回は本発明に従って製造されたエレクトロルミネツセント装置を示す。これは酸化スズインジウムの半透明被膜16で被覆されたガラス製支持体14からなる陽極12を含む。この上に正孔インジエクション層18が配置される。発光層20は層18上に配置される。層18 および20の一方または双方が薄膜形成性化合物である。陰極22は層20上に配置され、リードワイヤ24 が装置を電源26に接続する。電源26を入れると陽極12で発生した正孔は層18と20の界面へ伝達され、ここで陰極22から伝達された電子と結合し、可視光線hャを発する。

電源26が装置10の最大出力点の電圧たとえば15~25ボルトで操作される場合、最大電力転換効率は少な40くとも9×10-5W/Wである。ある場合にはこの効率が2×10-3に及ぶことが認められた。本発明の装置は改良された電力転換効率の結果1700cd/m²(500フィートランベルト)に及ぶ最大輝度を生じることが認められた。

本発明のEL装置は常法により作成される。すなわち正 孔インジエクション層、発光層および陰極をそれぞれ溶 液被覆法または蒸発により施す。正孔インジエクション 層が最初に形成されることが好ましい。発光層に有用な 溶剤が正孔インジエクション層に対しても良好な溶剤で ある場合、発光層を形成するためには蒸発が好ましい。

こで用いられる"蒸発"には蒸気相からの沈着のあらる形態が含まれ、真空下で行われるものも含まれる。 記の実施例により本発明をさらに説明する。これらの施例において最大輝度は不可逆的破壊を生じる電圧のぐ下の電圧で測定される。若干の実施例において駆動 Eについて25 Vという好ましい限度を越える輝度にする電圧が示されているのはこのためである。

#### 施例1

1 図のものと類似したエレクトロルミネツセント装置以下 "セル")を以下により製造した。

) 陽極を作成するため、ネザトロンガラスをまず 0.5 μmアルミナの研摩材で数分間研摩した、次いでイプロピルアルコールおよび蒸留水の1:1(V)混合物で超音波清浄した。次いでこれをイソプロピルアルコルですすぎ、窒素で送風乾燥させた。最後に、使用前これをトルエン中で超音波洗浄し、窒素で送風乾燥さた。

) 1,1-ピス(4-ジーpートリルアミノフェニ) シクロヘキサン(HI-1)をネザトロンガラス上一般的な真空蒸着法により沈着させた。すなわち上記 20 質を電気的に加熱されたタンタル製ポートから320 の温度で5×10<sup>-5</sup>トルの系内圧力において蒸発させ、ネザトロンガラスに沈着した生成HI-1フィルム\*

16

\*の厚さは75mmであった。

3) 次いで4,4'ービス(5,7ージーtーペンチルー2ーペンゾキサゾリル)スチルペン(E1)を2)に記載したと同じ手法を用いて、ただし供給源温度350℃を採用してHI-1層の上部に沈着させた。E1層の厚さも75mであった。

4)次いでインジウムをE 1 フィルムの上部にシャドーマスクを介して沈着させた。 I n電極の面積はO. 1 cm <sup>2</sup>であり、これもエレクトロルミネツセントセルの有効

10 面積を規定した。

出来上がったセルはセザトロンガラス電極をプラスとしてバイアスをかけた場合、青緑色の光を放出した。放出された光は520nmに最大放出を有していた。違成された最大輝度は与えられた電圧が22Vである場合、電流密度140mA/cm²において340cd/m²であった。20Vで駆動した場合、最大電力転換効率は1.4×10~3W/Wであり、最大エレクトロルミネツセント量子効率は1.2×10~3米子/電子であった。

#### 実施例2

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを 製造した。ただし下記の螢光増白剤を発光層として用い た。

2,5-ビス(5,7-ジーtーペンチルー2ーベンキサゾリル)-1,3,4-チアジアゾール) 施例1と同様にしてセルを製造した。ただし螢光増白の蒸発のための供給源温度は260℃であった。放出さた光は橙色であり、590nmに最大放出を有していた。られた最大輝度は30 Vおよび40mA/cm²において40cd/m²であった。20 Vで駆動された場合、最大力転換効率は1.5×10-3W/Wであり、最大EL※

※量子効率は1.4×10<sup>-2</sup>光子/電子であった。
実施例3

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを 製造した。ただし2,2'-(p-フェニレンジビニレン) ビスペンゾチアゾール(E3)を発光層として用い、 300℃で蒸発させた。

のセル (ネザトロン/HI-1/E3/In) 緑色の光を放出し、これは560mk最大放出を有しいた。得られた最大輝度は17.5 Vおよび200mA/c において340cd/m²であった。15 Vで駆動した場 、最大電力転換効率は4×10-4W/Wであり、最大 レクトロルミネツセント量子効率は3×10-3光子/★50

★量子であった。

実施例4

発光層用の他の物質

前記実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを製造した。ただし2-(4-ピフェニル)-6-フェニルペンゾキサゾール(PBBO)を発光層としてE

1の代わりに用い、200℃で蒸発させた。

このセル(ネザトロン/HI-1/PBBO/In)は 白青色の光を放出した。得られた最大輝度は25Vおよ 10 び50mA/cm²において34cd/m²であった。20Vで駆動 した場合、最大電力転換効率は9.5×10~5W/Wで\* 18

\*あり、最大エレクトロルミネツセント量子効率は8×1 0-4光子/電子であった。

実施5および6・

発光層用の他の物質

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを 製造した。ただし発光層はE1の代わりに2, 5-ビス $(5-(\alpha,\alpha-ジメチルベンジル)-2-ベンゾキサ$ ゾリル)チオフエン(実施例5)および<math>2, 5-ビス(5,7-ジーt-ベンチル-2-ベンゾキサゾリル)-3, 4-ジフェニルチオフェン(実施例6)からなり、340℃の温度で蒸発させた。表口に結果を示す。

※製造した。ただし、1,1,4,4ーテトラフェニルー

1,3-ブタジエン (TPB) を発光層として用いた。

			<u> </u>		11 .	
実施例	色	最大放出	最大輝度	最大電力転換効率	最大且量子効率	效率測定駆動電力
<b>.</b> 5	緑	530 <sub>mm</sub>	680ct/元 (19Vおよび150mA/cdにおいて)	7×10-14/4	5×10 <sup>-3</sup> 量子/電子	15V
. 6	. "	'n	1700cd/nt (20Vおよび300mA/cがにおいて)	1.4×10 <sup>-1</sup> ¥/¥	8.4×10 <sup>-1</sup> 量子/電子	14 <b>V</b>

実施例7

薄膜形成性でない電子伝達化合物

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを※

TPB昇華のための供給源温度は210℃であった。このセルは背色の光を放出し、これは450nmに最大放出を有していた。得られた輝度は20Vおよび200mA/cm²において102cd/m²であった。15Vで駆動した場合、最大電力転換効率は2×10<sup>-4</sup>W/Wであり、最大エレクトロルミネツセント量子効率は1.2×10<sup>-3</sup>光子/量子であった。このセルは蒸発したTPB層の不均質なかつ薄膜形成性でない性質にもかかわらず機能した。TPB層は顕微鏡下で見た場合小さなクラスターのモザイクの外観を有していた。

実施例8および9

電子伝達化合物として8-ヒドロキシノリノの金属錯体を使用

実施例1と同様にしてエレクトロルミネツセントセルを 製造した。ただしビス (8-ヒドロキシキノリノ) アル ミニウム (実施例8)、および次式

の構造をもつビス(8-ヒドロキシキノリノ)マグネシウムをそれぞれ発光層として用いた。操作条件は実施例1の記載と同様であった。ただし金属錯体の供給派温度はそれぞれ330℃(実施例8)および410℃(実施例9)であった。表IIIに結果を示す。

-			<u>双</u>			
実施 例	放出された光の色	最大放出 の波長	最大輝度(cd/nl)	最大電力転換効率(『/『)	最大日.量子効率	駆動 電力
8	緑	515nm	340 (15Vおよび50mA/cはにおいて)	8,2×10 <sup>-4</sup>	5.8×10 <sup>-8</sup> 光子/量子	15V
9 .	禄	548nm	340 (24Vおよび100mA/d記さいて)	1,4×10 <sup>-4</sup>	1.5×10 <sup>-3</sup> 光子/量子	<b>24</b> V

R各実施例に示した効率を便宜のため第2図にプロツ した。第2図の点線は傾向を示すにすぎず、いずれか 方法による最適なものを表わすものではない。そこに されたデータは関係式

:(電力転換効率)=log(EL量子効率)+logK 上記式中Kは切片 (intercept) であり、駆動電圧にって一部制御される係数である) に従うとほぼ直線状 ある。駆動電圧 (第1図の電源26) の値が上がるの キって、第2図の曲線は下方へ移動する。従ってより い駆動電圧では、同一のEL電子効率でも、もはや希 する9×10<sup>-5</sup>W/Wの電力転換効率を与えないよう よるであろう。

3面の簡単な説明]

第1図は電源に接続した本発明装置の一部の概略的断面 図であり、

第2回は本発明装置に関する電力転換効率対エレクトロ 10 ルミネツセント量子効率を示す対数一対数グラフであ る。

図中の各配号は下配のものを表わす。

10:エレクトロルミネツセント装置:

12:陽極;14:ガラス製支持体:

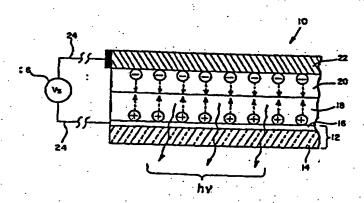
16: 半透明被膜:

18:正孔インジエクション層;20:発光層;

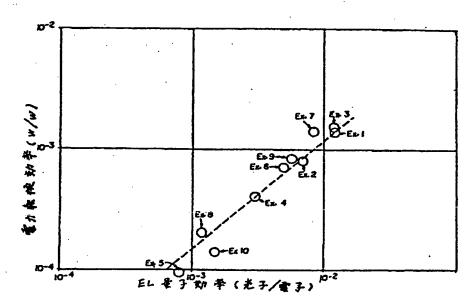
22:陰極:24:リードワイヤ:

26:電源。

【第1図】



【第2図】



		- <del>-</del>
<b>* * * * * * * * * *</b>		
		en e
		1
	And the second s	
		*
	•	
		The second se
		•
	95	
	grande de la companya della companya della companya de la companya de la companya della companya	w No
		en e
		en e
The state of the s		•
		•
행사 과 사 : 		
着 ·		
₩		
<b>\$</b>		
		•
And the second of the second o		
4		
The second secon		
,	-	